

sochacki

MARIUSZ SOCHACKI

Mariusz Sochacki urodził się 25 lutego 1977 roku w Warszawie, gdzie w 1996 roku ukończył XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, uczęszczając do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki i Techniki Informatycznych Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera w 2000 roku na specjalności Mikroelektronika i Optoelektronika oraz tytuł magistra i stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem na specjalności Elektronika odpowiednio w 2002 oraz 2007 roku. W 2000 roku był współzałożycielem Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki Politechniki Warszawskiej, w którego pracach uczestniczył aktywnie do dnia dzisiejszego. W latach 2007–2010 pracował w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na stanowisku starszego specjalisty ds. realizacji projektów badawczych i był jednym z głównych współwykonawców kilku podprojektów realizowanych w ramach projektu badawczego zamawianego *Nowe technologie na bazie węgla krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości*, dużych mocy i wysokich temperatur, w ramach którego powstały pierwsze w Polsce demonstratory przyrządów mocy na podłożu SiC. Brał udział i uczestniczył obecnie jako wykonawca w kilku projektach 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie opracowania czujników promieniowania rentgenowskiego na bazie warstw diamentowych wykorzystywanych w radioterapii medycznej, opracowania technologii montażu układów elektronicznych typu BGA, opartej na kulkach o średnicy poniżej 100 μm oraz identyfikacji podrabianych układów półprzewodnikowych przy użyciu technik rentgenowskich. W tym samym okresie powołany został na



członka Sekcji Technologii Elektronowej i Materiałów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Od 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego jednocześnie w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Podstawowym obszarem jego zainteresowania jest technologia przyrządów mocy na podłożach z węgla krzemu od poziomu modelowania charakterystyk elektrycznych i procesów technologicznych do poziomu ich wytwarzania i charakteryzacji. Jest współautorem 17 artykułów naukowych, w tym 8 w renomowanych czasopismach międzynarodowych z tzw. listy filadelfijskiej, opiekunem naukowym 3 prac dyplomowych, recenzentem kilkunastu artykułów naukowych w pismach: „Microelectronics Reliability”, „Thin Solid Films”, „Solid State Electronics”, „Elektronika”. W 2010 roku był jednym z głównych organizatorów międzynarodowej konferencji naukowej „5th Wide Band-gap Materials — Progress in Synthesis and Applications” skupiającej międzynarodowe grono specjalistów zajmujących się technologią półprzewodników szerokopasmowych.

Słowa kluczowe

- węgiel krzemu
- przyrządy półprzewodnikowe mocy
- elektronika wysokotemperaturowa
- technologia wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
- charakteryzacja elektryczna
- spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS)